

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年6月16日(2005.6.16)

【公表番号】特表2000-504494(P2000-504494A)

【公表日】平成12年4月11日(2000.4.11)

【出願番号】特願平10-521599

【国際特許分類第7版】

H 0 1 L 21/768

H 0 1 L 21/28

H 0 1 L 23/12

H 0 5 K 3/26

【F I】

H 0 1 L 21/90 A

H 0 1 L 21/28 L

H 0 5 K 3/26 B

H 0 1 L 23/12 N

【手続補正書】

【提出日】平成16年10月26日(2004.10.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】補正の内容のとおり

【補正方法】変更

【補正の内容】

手 続 補 正 書

平成16年10月26日

特許庁長官 小 川 洋 殿

1. 事件の表示

平成10年特許願第521599号

2. 補正をする者

名称 ダブリュ. エル. ゴア アンド アソシエイツ,  
インコーポレイティド

3. 代 理 人

住所 〒105-8423 東京都港区虎ノ門三丁目5番1号 虎ノ門37森ビル  
青和特許法律事務所 電話 03-5470-1900

氏名 弁理士(7751)石田 敬



4. 補正対象書類名

明細書及び請求の範囲

5. 補正対象項目名

明細書及び請求の範囲

6. 補正の内容

(1) 明細書第15頁第7行~第8行、「100mm (0.0039” (3.9mil))」を『100μm (0.0039” (3.9mil))』と補正する。

(2) 請求の範囲を別紙の通り補正する。

7. 添付書類の目録

請求の範囲

1通



### 請求の範囲

1. 基板を用意し、レーザーによってこの基板に少なくとも1つのバイアを孔あけすることを含む、基板にバイアを形成する方法であって、

前記基板のバイアをナトリウムエッチングで洗浄することによって、レーザーによる孔あけの際に生じた切除された物質を取り除くことを含む、基板にバイアを形成する方法。

2. 前記ナトリウムエッチングを、有機媒質中のナトリウム分散液を使用して行う、請求項1に記載の方法。

3. 前記ナトリウムエッチングを、ナフタレン中のナトリウム分散液を使用して行う、請求項2に記載の方法。

4. 前記基板が、多孔質有機材料から作られた誘電体層を含む、請求項1に記載の方法。

5. 前記多孔質有機材料が、フルオロポリマーマトリックスを含む、請求項4に記載の方法。

6. 前記多孔質有機材料が、延伸膨張ポリテトラフルオロエチレンである、請求項5に記載の方法。

7. 前記多孔質有機材料が、吸収されたまたは含浸された熱硬化性または熱可塑性樹脂、接着剤樹脂および充填剤の混合物を含有する多孔質マトリックス系を含む、請求項4に記載の方法。

8. 前記基板が、マルチチップモジュールである、請求項1に記載の方法。